

課題番号	: F-12-OS-0021
支援課題名（日本語）	: 透明伝導膜応用に向けたカーボンナノチューブ薄膜の作製と評価
Program Title (in English)	: Fabrication and evaluation of carbon nanotube thin film for transparent conductive films
利用者名（日本語）	: 根岸 良太
Username (in English)	: Negishi Ryota
所属名（日本語）	: 大阪大学大学院 工学研究科
Affiliation (in English)	: Osaka University, Graduate School of Engineering

概要 (Summary) :

固体ナノ微粒子を成長核として合成したカーボンナノチューブ(CNT)薄膜の透明伝導膜応用に向けて、4端子法による抵抗測定から、薄膜中のCNT密度と伝導度の関係を明らかにする。

実験 (Experimental) :

利用した装置：マスクアライナー、反応性イオンエッチング装置、EB蒸着装置

本課題で進めた4端子デバイスの作製プロセスは次の通りである。(1) Si基板上にCNT薄膜を作製したサンプルに、フォトリソグラフィとEB蒸着により金属アライメントパターンを作製。(2) 測定するCNT薄膜を反応性イオンエッチングによりパターニング。(3) フォトリソグラフィとEB蒸着による電極パターンの作製。アライメントおよび電極パターン作製において、フォトリソグラフィの露光時間(8秒)と現像時間(30秒)を最適化した。

結果と考察 (Results and Discussion) :

図1に、最適化した条件により作製した描画パターンを示す。最小線幅 $\sim 1\mu m$ の細線が正確に形成されていることから、十分な描画精度を有していることが確認された。一方で、アライメントを利用して二つの描画パターンの位置精度を確認した実験結果を図2に示す。一回目のパターン(A)と二回目のパターン(B)のずれは、 $\sim 20\mu m$ 以上生じることが確認された。位置合わせに用いる光学顕微鏡の倍率を踏まえても、このずれは、非常に大きい値である。これは、マスクパターンとサンプル基板が密着する際に、マスクあるいはステージがランダムに動いてしまうことが原因であることが分かった。これは、装置を調整・オーバーホールする必要があるものと思われる。

その他・特記事項 (Others) :

今後の課題：1~2 μm の位置精度実現を目指して、

マスクアライナーの再調整あるいはレーザー描画装置の利用を検討する。

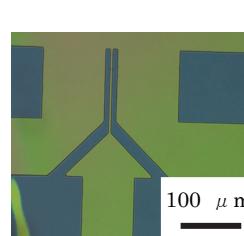


図1. 現像後の描画パターン

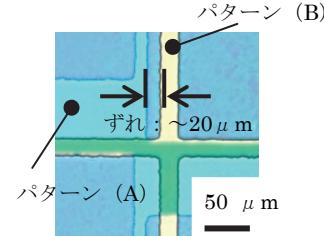


図2. 2つの描画パターンのずれ

共同研究者等 (Coauthor) :

小亀平章 大阪大学大学院工学研究科 博士前期2年生
岩井良真 大阪大学大学院工学研究科 博士前期2年生

論文・学会発表 (Publication/Presentation) :

なし

関連特許 (Patent) :

なし